Catálogo de produtos

Amplificadores de potência LDMOS

Amplificadores LDMOS usam transistores MOS de difusão lateral para elevar a potência RF. Casamento, polarização, picos do sinal e caminho térmico completo determinam os limites de operação.



Produtos: 2

Revisão: 2 · Data da revisão: 2026-11-11



LCPAM-20-520-200A

Módulo amplificador de potência RF LDMOS de 20–520 MHz, 200 W saturados

O módulo com estágio final LDMOS cobre 20–520 MHz com potência saturada típica de 200 W. A saída no ponto de compressão de 1 dB é especificada separadamente em 50 W típicos, com ganho de pequenos sinais típico de 53 dB.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 20; Máximo: 520; Unidade: MHz

Potência RF de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 200; Unidade: W

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 50; Unidade: W

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: G; Típico: 53; Unidade: dB

25 °C; 50 Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-20-520-350

Amplificador LDMOS RF de 20–520 MHz, saída saturada típica de 350 W

O amplificador LDMOS cobre 20–520 MHz com saída saturada típica de 350 W e saída típica de 150 W na compressão de 1 dB. O ganho típico é 56 dB, a corrente 29 A a 350 W e a alimentação típica 48 VDC.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 20; Máximo: 520; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P-1dB; Típico: 150; Unidade: W

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 350; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Típico: 56; Unidade: dB

+48.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.